### 01;10 Аксептанс и пропускание квадрупольного фильтра масс с амплитудной модуляцией высокочастотного напряжения с учетом краевого поля

© Н.В. Коненков, А.Н. Корольков, Ю.В. Страшнов

Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина, 390000 Рязань, Россия e-mail: n.konenkov@rsu.edu.ru

(Поступило в Редакцию 9 ноября 2009 г. В окончательной редакции 26 января 2010 г.)

Развит метод расчета аксептанса квадрупольного фильтра масс с амплитудной модуляцией высокочастотного напряжения. Ключевым фактором при нахождении преобразования фазового эллипса краевыми полями является учет набега фазы высокочастотного поля при движении ионов во входном краевом поле. Характер изменения комбинированного аксептанса в зависимости от аксиальной энергии ионов (или времени пролета ионами краевого поля) согласуется с рассчитанным коэффициентом пропускания, что указывает косвенно на справедливость предлагаемого подхода.

### Введение

Впервые экспериментально влияние дополнительного высокочастотного (ВЧ) напряжения на форму массового пика наблюдалось Девантом в 1989 г. [1], но природа этого явления не была раскрыта. Позже Козо [2,3] описал воздействие дополнительного квадрупольного ВЧ-поля малой амплитуды в терминах "of unstable band generation inside a stable band", что соответствует параметрическому резонансу первого порядка [4,5]. Теория квадрупольного параметрического резонансного возбуждения колебаний ионов первого порядка представлена Альфредом и др. [4]. Далее Судаковым и др. [5,6] теоретически было показано, что полосы нестабильности создаются параметрическим резонансом высокого порядка, в результате чего рабочая область расщепляется на острова стабильности.

В спектре колебаний ионов в квадрупольном радиочастотном электрическом поле существуют частоты, которые соответствуют *периодическим* колебаниям ионов. Возбуждение резонансных колебаний ионов дополнительным периодическим сигналом на кратных указанных частотах позволяет осуществить различные методы манипулирования ионами. Резонансное поглощение энергии от дополнительного генератора рассматривалось как метод детектирования ионов в трехмерной ионной ловушке Паулем и др. [5,7] при зарождении квадрупольной масс-спектрометрии. С развитием квадрупольной массспектрометрии метод параметрического резонансного возбуждения нашел широкое применение для:

a) удаления ионов заданной массы из области удержания;

б) контроля эндотермических реакций захваченных ионов;

в) масс-селективного сканирования ионов в ловушке Пауля и линейной ловушке [4,8].

Параметрический резонанс — это явление увеличения амплитуды колебаний при периодическом изменении

параметра осциллирующей системы. В нашем случае колебательная система — это ион в квадрупольном ВЧ-поле. Ее параметрами являются постоянное напряжение U, амплитуда V переменного ВЧ-напряжения и частота  $\Omega$ . Таким образом, технически квадрупольный резонанс можно осуществить путем амплитудной модуляции постоянного напряжения

 $U[1+m\cos(\omega t+\alpha)],$ 

переменного ВЧ-напряжения

 $V\cos\Omega t \left[1 + m\cos(\omega t + \alpha)\right],$ 

полного питающего напряжения [4,9]

$$(U + V \cos \Omega t) [1 + m \cos(\omega t + \alpha)],$$

а также фазовой или частотной модуляции ВЧ-напряжения [8]

$$V\cos|\Omega t + m\cos(\omega t + \alpha)|$$

где m — параметр модуляции,  $\omega$  — частота модулирующего сигнала. Параметрического резонанса можно достичь также, используя дополнительное ВЧ-напряжение  $V' \cos \omega t$ , подавая на противоположные пары электродов напряжение вида

$$\pm [U + V \cos \Omega t + V' \cos(\omega t + \alpha)],$$

где *а* — сдвиг фаз [4–6,10].

В работе [9] представлены результаты исследования режима работы квадрупольного анализатора с амплитудной модуляцией рабочих напряжений. При этом не принимался во внимание сдвиг фаз между ВЧ-напряжением и модулирующим сигналом, а начальная фаза влета ионов в ВЧ-поле учитывалась на интервале периода ( $\pi$ ) основного ВЧ-напряжения. Однако учет этого фактора на интервале общего периода ВЧ-напряжения и модулирующего сигнала может существенно повлиять на результат. Аксептанс фильтра масс исследовался в работе [11] для случая квадрупольного возбуждения с помощью дополнительного ВЧ-напряжения низкой частоты, но без учета краевых входных полей. В связи с этим представляет практический интерес изучение аксептанса фильтра масс при работе в верхнем острове стабильности, возбуждаемом амплитудной модуляцией ВЧ-напряжения высокой частоты  $v = \omega/\Omega = 9/10$  с учетом указанных факторов.

Частота  $\omega = (9/10)\Omega$  выбрана из практических соображений. Когда частота модуляции  $\omega$  и частота ВЧ-напряжения  $\Omega$  близки, спектр временны́х гармоник с частотой  $\Omega - \omega$ ,  $\Omega$ ,  $\Omega + \omega$  не будет сильно подавлен высокодобротным *LC*-контуром нагрузки ВЧ-генератора.

# Уравнения движения и рабочий остров стабильности

Используемые уравнения движения ионов по поперечным координатам *x* и *y* анализатора имеют вид [5,12]:

$$\frac{d^2x}{d\xi^2} + \left\{ a - 2q\cos 2(\xi - \xi_0) \times \left[ 1 + m\cos(2\nu(\xi - \xi_0) + 2\alpha) \right] \right\} f(z)x = 0, \quad (1)$$

$$\frac{d^2 y}{d\xi^2} - \left\{ a - 2q \cos 2(\xi - \xi_0) \right. \\ \left. \times \left[ 1 + m \cos \left( 2\nu(\xi - \xi_0) + 2\alpha \right) \right] \right\} f(z) x = 0, \quad (2)$$

$$z = \frac{z_f \xi}{n_f \pi},\tag{3}$$

$$f(z) = 1 - \exp(-2.13z - 1.55z^2),$$
 (4)

где

$$a = \frac{8eU}{m_i \Omega^2 r_0^2}, \quad q = \frac{4eV}{m_i \Omega^2 r_0^2}, \quad \nu = \frac{\omega}{\Omega}, \quad \xi = \frac{\Omega t}{2}, \quad (5)$$

 $\xi_0$  — начальная фаза влета иона в ВЧ-поле, е и  $m_i$  — заряд и масса иона, U — постоянное напряжение, V — амплитуда ВЧ-напряжения,  $r_0$  — радиус вписанной окружности между вершинами четырех электродов фильтра масс (радиус поля [13]),  $\omega$  — частота модуляции, m — параметр модуляции (индекс модуляции),  $\alpha$  — сдвиг фаз между ВЧ-напряжением и сигналом модуляции, z — осевая безразмерная координата,  $n_f$  — число периодов ВЧ-поля пребывания ионов в краевом поле с линейным размером  $z_f = 1.5r_0$ .

Уравнения (1)-(3) описывают движение ионов в краевом поле с экспоненциально возрастающим потенциалом (4) на входе фильтра масс [14,15] и при f(z) = 1 — движение ионов в квадрупольном поле анализатора [5,12].

При модуляции на относительной частоте  $v = \omega/\Omega = K/P$ , когда v — простая несократимая дробь,

*К* и *Р* — целые числа, причем K < P, полосы нестабильности следуют вдоль изо- $\beta$ -линий ( $\beta$  — параметр стабильности или характеристический показатель) [5]:

$$\beta = \frac{K}{P}, \quad K = 1, 2, \dots, P - 1.$$
 (6)

Здесь исследуется верхний остров стабильности, формируемый полосами нестабильности с  $\beta_x = (P-1)/P$  и  $\beta_y = 1/P$ . В частности, при  $\nu = 9/10$  наиболее интенсивные полосы локализуются вдоль  $\beta_x = 0.9$  и  $\beta_y = 0.1$  вблизи границ невозмущенной первой области стабильности. Поэтому выбор  $\nu = 9/10$  обусловлен также этим обстоятельством.

Для нахождения положения острова стабильности на плоскости параметров a, q рассчитывалась матрица преобразования M(a, q) начальных координат и скоростей  $\{u = 0 \text{ и } du/d\xi = 1\}$  и  $\{u = 1 \text{ и } du/d\xi = 0\}$  за период  $\pi P$ . Если след матрицы SpM(a, q) < 2, то точка a, qпопадает в остров стабильности. Условие SpM(a, q) = 2соответствует границам островов стабильности. Более подробно численный метод расчета положения острова на плоскости a, q описан в работе [5].

На рис. 1 показан верхний остров стабильности на плоскости параметров a, q для трех значений параметра модуляции m = 0.01, 0.02 и 0.03 при относительной частоте модуляции  $v = \omega/\Omega = 9/10$ . С увеличением параметра модуляции m уменьшается площадь четырехугольника (острова) стабильности и остров смещается вверх по оси a. Каждый из них может быть использован для разделения ионов по удельным зарядам, как и в случае первой области. В острове существуют две рабочие вершины — верхняя **В** и нижняя **D**, вблизи которых возможна настройка разрешающей способности путем изменения наклона линии сканирования  $a = 2\lambda q$ . Линия сканирования, проходящая через вершину **C**,



**Рис. 1.** Острова стабильности при амплитудной модуляции высокочастотного напряжения для параметров модуляции m = 0.01 (•), 0.02 (•) и 0.03 (•). Отношения частот  $v = \omega/\Omega = 9/10$ . В и **D** — рабочие вершины, пунктир —  $\lambda = 0.16549$ .

соответствует минимальной разрешающей способности  $R = q/\Delta q \approx 64$  для четырехугольника с m = 0.01.

Метод расчета аксептанса апробировался не только в одной рабочей точке a, q четырехугольника вблизи вершины **D**. Контуры аксептанса квадрупольного фильтра масс подобны и в других островах (различаются незначительно), изменяется лишь площадь, ограничиваемая контурами.

### Расчет эллипсов захвата

В динамике аксептанс квадрупольного фильтра масс (КФМ) характеризуется эллипсами захвата [8,13,16,17] на фазовой плоскости начальных координат и скоростей u и  $du/d\xi$  (u — координата x или y):

$$\Gamma u^2 + 2Au \,\frac{du}{d\xi} + B \left(\frac{du}{d\xi}\right)^2 = \varepsilon,\tag{7}$$

где A, B и  $\Gamma$  — параметры эллипса захвата, которые зависят от a, q и начальной фазы  $\xi_0$  и выражаются через элементы матрицы преобразования M(a, q) [5]:

$$A(\xi_0) = \frac{[m_{11}(\xi_0) - m_{22}(\xi_0)]_{\pi P}}{2\sin\pi\beta}, \quad B(\xi_0) = \frac{[m_{12}(\xi_0)]_{\pi P}}{\sin\pi\beta},$$
$$\Gamma(\xi_0) = -\frac{[m_{21}(\xi_0)]_{\pi P}}{\sin\pi\beta}.$$
(8)

Величину  $\varepsilon$  называют аксептансом. Она равна площади эллипса, деленной на  $\pi$ . Период изменения начальной фазы  $\xi_0 - [0 - \pi P]$  и период сдвига фаз  $\alpha$  составляет  $\pi$ , что соответствует периоду ВЧ-напряжения модулирующего сигнала с частотой  $\omega$ .

Эллипсы захвата (или фазовые эллипсы [6]) модифицируются входными краевыми полями. Учет влияния входного краевого поля на аксептанс КФМ учитывается матрицей преобразования  $M_f$ , которая устанавливает связь между входными координатами и скоростями  $u_a$ и  $(du/d\xi)_a$  и выходными —  $u_e$  и  $(du/d\xi)_e$  [13–15,17]:

$$\begin{bmatrix} u_e \\ \dot{u}_e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C & S \\ C' & S' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_a \\ \dot{u}_a \end{bmatrix} = M_f \begin{bmatrix} u_a \\ \dot{u}_a \end{bmatrix}$$
(9)

при начальных условиях  $u_a = 1$ ,  $\dot{u}_a = 0$  и  $u_a = 0$ ,  $\dot{u}_a = 1$ . Индекс "*a*" соответствует входной апертуре, а индекс "*e*" — входной границе полного поля. Пусть  $n_f$ есть число периодов ( $\Omega/2\pi$ ), за которое ион пролетает краевое поле. Для того чтобы учесть задержку по времени  $\pi n_f$  между входом ионов на входную апертуру и попаданием в основное ВЧ-поле, матрицу преобразования  $M_f$  определяем за полный период  $\pi P$ , включающий время пролета  $\pi n_f$ . Тогда модифицированные параметры эллипсов захвата  $A_a$ ,  $B_a$  и  $\Gamma_a$  можно выразить через параметры A, B,  $\Gamma$  как [13,17]

$$\begin{bmatrix} B_{a}(\xi_{0}) \\ A_{a}(\xi_{0}) \\ \Gamma_{a}(\xi_{0}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S'^{2} & 2SS'' & S^{2} \\ C'S' & C'S + S'C & CS \\ C'^{2} & 2CC' & C^{2} \end{bmatrix}_{P\pi} \begin{bmatrix} B(\xi_{0}) \\ A(\xi_{0}) \\ \Gamma(\xi_{0}) \end{bmatrix}.$$
(10)

Для расчета матрицы  $M_f$  использовалась краевая модель входного краевого поля с экспоненциально нарастающим потенциалом [14,15]. Зная модифицированные параметры  $A_a$ ,  $B_a$  и  $\Gamma_a$ , можно рассчитать контуры аксептанса (предельный аксептанс) по заданному уровню. Метод построения контуров изложен подробно в работах [11,15].

## Аксептанс квадрупольного фильтра масс

На рис. 2 показаны параметры А, В и Г эллипсов захвата для поперечных координат х и у в зависимости от начальной фазы  $\xi_0$  при двух значениях сдвига фаз  $\alpha = 0$ и  $\pi/2$  в рабочей точке a = 0.2331, q = 0.69965 вблизи вершины **D**. При соотношении частот  $v = \omega/\Omega = 9/10$ период изменения начальной фазы равен 10*π*. Как и ожидалось, с изменением сдвига фаз  $\alpha$  на  $\pi/2$  зависимости  $A(\xi_0)$ ,  $B(\xi_0)$  и  $\Gamma(\xi_0)$  смещаются на 5 $\pi$ . Параметры эллипсов А, В и Г изменяются с периодом 10 л и огибающая этих параметров соответствует характеру изменения A, B и  $\Gamma$  на периоде  $\pi$  в невозмущенной первой области стабильности [13]. Имеет место модуляция параметров фазовых эллипсов с периодом л, что соответствует периоду  $T_0 = 2\pi/\Omega$  ВЧ-напряжения. Максимально значение  $B_{\text{max}} = B(\xi_0)$  на периоде  $0 - 10\pi$ определяет величину аксептанса  $\varepsilon = 1/B_{\text{max}}$  (площади эллипса, деленной на  $\pi$ ) [13, стр. 87]. Характер изменения параметров эллипсов захвата А, В и Г от начальной фазы  $\xi_0$  в четырехугольнике (рис. 1) существенно иной, чем в первой области стабильности [13,16]. Поэтому зависимости A, B и  $\Gamma$  от начальной фазы  $\xi_0$  приведены полностью. Параметр  $\Gamma$  имеет размерность  $1/r_0^2 [1/m^2]$ , параметр  $A - \pi f [1/s]$  и параметр  $B - 1/(\pi f r_0)^2 [(m/s)^2]$ . Здесь  $f = 2\pi/\Omega$  — циклическая частота основного ВЧ-напряжения.

На рис. 3 приведены эллипсы захвата для координат xи y при указанных начальных фазах  $\xi_0$ . Смысл этих эллипсов состоит в том, что если начальные скорость и координата при начальной фазе  $\xi_0$  попадают внутрь эллипса, то ион будет совершать колебания с амплитудой менее  $r_0$ , пройдет анализатор и будет зарегистрирован детектором. Эллипсы вращаются с частотой  $\Omega$  на фазовой плоскости начальных поперечных координат и скоростей.

На рис. 4 показаны предельные аксептансы для вершины **D**, определенные по заданному уровню пропускания 50, 75 и 100% для координат x и y, когда краевые поля отсутствуют ( $n_f = 0$ ) и в точке a, q, соответствующей максимуму пропускания КФМ (рис. 5). Точки на границе контура, определенного, например по уровню пропускания 50%, соответствуют 500 эллипсам из 1000. Все ионы, имеющие начальные положения и скорости, которые попадают в контур 100% на фазовой плоскости, пройдут анализатор без потерь независимо от начальной



**Рис. 2.** Зависимости параметров эллипсов захвата A, B и  $\Gamma$  от начальной фазы  $\xi_0$  для координат x(a) и y(b) в рабочих точках  $a = \pm 0.2331, q = \pm 0.69965$  и при двух значениях сдвига фаз  $\alpha$ ; m = 0.02.

фазы влета ионов в ВЧ-поле. Это соответствует коэффициенту пропускания КФМ 100%. Контуры подобны, при изменении разрешающей способности изменяется лишь площадь, ограничиваемая контуром.

Модифицированные контуры пропускания в нижней рабочей вершине **D** на фазовых плоскостях x,  $dx/d\xi$  и y,  $dy/d\xi$  для уровня пропускания 50% приведены на рис. 6. Как и в случае обычного режима работы, в первой области стабильности [15] величина предельного аксептанса (площадь, ограничиваемая контуром) возрастает с увеличением времени  $\pi n_f$ , достигает максимума и убывает на периоде  $10\pi$ . С увеличением числа периодов пребывания инов в краевом поле  $n_f$  контуры смещаются вниз в сторону отрицательных значений поперечных скоростей. Это предполагает слабую фокусировку входного пучка ионов на вход квадруполя с целью увеличения пропускания КФМ.

Зависимости величин предельных аксептансов  $S_x$  и  $S_y$ , определенных по уровню пропускания 50%, от числа периодов пребывания ионов в краевой области n<sub>f</sub> показаны на рис. 7. Величины (площади) аксептансов S<sub>x</sub> и S<sub>v</sub> различаются (на этом рисунке) приблизительно на порядок. Величина S<sub>x</sub> возрастает на интервале  $n_f = 0-3$  и практически не изменяется вплоть до  $n_f = 6$ . Кривая  $S_{v}(n_{f})$  достигает максимума приблизительно при  $n_f = 3$ . Мерой пропускания КФМ в целом может служить произведение  $S_x S_y$  (величина комбинированного аксептанса), которое достигает максимума при  $n_f = 3$ . Определяет полный аксептанс КФМ величина меньшего аксептанса по у координате. Это имеет место и при обычном режиме сепарации в первой области стабильности [13,15], а также при работе в третьей области стабильности в нижней вершине [18]. Отметим общее свойство входных краевых полей, заключающееся в увеличении ими аксептанса КФМ. Величины  $S_x$  и  $S_y$ , приведенные на рис. 7 и 3 [18], различаются на два порядка, что связано с различием разрешающей способности: рабочая точка a, q в [18] соответствует низкой разрешающей способности R = 100.

Для проверки правильности модели аксептанса КФМ с параметрическим возбуждением колебаний ионов рассчитывался коэффициент пропускания с учетом краевых полей. Коэффициент пропускания  $T = N_{\rm tr}/N$  определяется как доля прошедших ионов через квадрупольный анализатор за единицу времени. N<sub>tr</sub> — число ионов, траектории которых имеют амплитуду колебаний менее r<sub>0</sub> на отрезке времени  $0-n\pi$ , где n — число ВЧ-периодов пребывания ионов в фильтре масс, период л соответствует периоду  $2\pi/\Omega$  ВЧ-поля. N — число ионов, которые попадают на входную апертуру. В каждую начальную фазу ВЧ-поля  $\xi_0 = 0, 1\pi/10, 2\pi/10, \dots, 100\pi/10$ в анализатор влетают 30 ионов со случайным гауссовым распределением начальных координат и скоростей, характеризуемым величинами  $\sigma_x$  и  $\sigma_v$ . Таким образом, каждая точка  $q_i$  на кривой пропускания T(q)соответствует расчету N = 3000 траекторий ионов по координатам х и у. Интегрирование уравнений движения (1), (2) и (9), (10) осуществлялось численным



**Рис. 3.** Эллипсы захвата на фазовых плоскостях поперечных координат и скоростей для указанных на рисунке значений начальной фазы  $\xi_0$ . a = 0.2331, q = 0.69965, m = 0.02, v = 9/10.



**Рис. 4.** Контуры аксептансов по координатам x(a) и y(b), определенным по уровням пропускания 50, 75 и 100%. a = 0.2331, q = 0.69965. Краевые поля отсутствуют  $(n_f = 0)$ .



**Рис. 5.** Форма пика (аппаратная функция) фильтра масс при работе вблизи нижней вершины **D** вдоль линии сканирования  $a = 2 \times 0.16658q$  ( $R_{0.1} = q/\Delta q = 2690$ ). Параметры источника ионов:  $\sigma_x = 0.015r_0$ ,  $\sigma_v = 0.0041\pi r_0 f$ , время сепарации: n = 300 периодов высокочастотного поля.

методом Рунге-Кутта-Нюстрёма-Дортманда-Принса (РК-N-DP) 6(7)-го порядка с переменным шагом интегрирования [15]. На рис. 5 показана форма пика (аппаратная функция анализатора) при относительной высокой разрешающей способности  $R_{0.1} = q/\Delta q = 2690$  и работе в нижней вершине **D** четырехугольника стабильности (см. рис. 1).



**Рис. 6.** Контуры аксептансов по координатам x(a) и y(b), модифицированным краевым полем для указанных на рисунке значений числа  $n_f$  периодов высокочастотного поля.



**Рис. 7.** Величины аксептансов  $S_x$  и  $S_y$  (площадей, ограниченных контурами, см. рис. 6) и их произведения  $S_x S_y$  от числа периодов пребывания ионов в краевом поле.  $-\circ - 10^4 S_x$ ,  $-\bullet - 10^4 S_y$ ,  $-\bullet - 10^8 S_x S_y$ .



**Рис. 8.** Влияние фазы влета  $\xi_0$  на коэффициент пропускания *T* фильтра масс.

Для достижения указанной разрешающей способности требуемое время сортировки составляет n = 300 периодов ВЧ-поля. Параметры модели источника ионов:  $\sigma_x = 0.015r_0$  — дисперсия начальных положений ионов на входной диафрагме,  $\sigma_v = 0.0041\pi r_0 f$  — тепловой разброс ионов массой 2700 Da по поперечным скоростям при комнатной температуре. Время пролета  $n_f = 3$  ВЧ-периода ионами краевой области с линейным размером  $z_f = 1.5r_0$  соответствует максимуму 50% комбинированного аксептанса (рис. 7).

На рис. 8 показана зависимость коэффициента пропускания T от фазы  $\xi_0$  влета ионов в ВЧ-поле в форме гистограммы. В каждый указанный интервал  $\pi$  (соответствует периоду  $2\pi/\Omega$  ВЧ-напряжения) через равные промежутки задавалось 30 начальных фаз и для каждой фазы задавалось 100 случайных начальных положений и поперечных скоростей частицы. Далее рассчитывались 3000 траекторий ионов и определялась доля ионов, имеющих радиальные смещения менее  $r_0$ . Можно видеть, что наибольшее пропускание имеет место, если начальные фазы находятся в интервале от  $4\pi$  до  $7\pi$ при сдвиге фаз  $\alpha = 0$ . Среднее значение коэффициента пропускания за период  $10\pi$  составляет 34% (отмечено пунктиром).

Влияние времени пролета ионами краевого поля, выраженное в числе  $n_f$  периодов ВЧ-поля, на коэффициент пропускания фильтра масс T, работающего с модуляцией ВЧ-напряжения, проиллюстрировано на рис. 9. Поведение зависимостей  $T(n_f)$  и  $S_x S_y(n_f)$  хорошо согласуется с учетом того, что эмиттанс источника ионов статичен и предельные 50%-ные аксептансы трансформируются при изменении времени пребывания ионов в краевом поле. Это является косвенным подтверждением справедливости модели аксептанса фильтра масс, работающего в четырехугольнике стабильности при параметрическом возбуждении колебаний ионов.



**Рис. 9.** Влияние краевого поля на коэффициент пропускания фильтра масс в рабочей точке a = 0.2331, q = 0.69963;  $n_f \pi$  — время пролета ионами краевого поля  $(2\pi n_f \Omega)$ .

Если учитывать начальную фазу влета ионов в ВЧ-поле только на интервале  $\pi$ , то пропускание T будет уже не на уровне 30% (рис. 5), а другим. Так, например, если влет ионов осуществляется в интервале  $\xi_0 = 5\pi - 6\pi$ , оно превысит 90% (рис. 8). Именно такие пропускания демонстрировались, например, в работе [14], где рассмотренный здесь подход (учет фазы на интервале  $\pi P$ ) не применялся. Технически таких высоких уровней пропускания можно достичь при фазовом импульсном вводе ионов, что предполагает синхронизацию сдвига фаз и времени ввода пучка ионов в анализатор [19,20].

### Обсуждение результатов

Развит метод расчета аксептанса, определенного по заданному уровню пропускания, для фильтра масс с параметрическим резонансным возбуждением колебаний ионов. Ключевым моментом предлагаемого метода является учет набега фазы  $\pi n_f$  ВЧ-поля при движении ионов в краевом поле. Для этого матрица преобразования M<sub>f</sub> рассчитывалась за полный интервал начальной фазы 0-10*π*, включая интегрирование уравнений движения (1) и (2) на интервале  $0-\pi n_f$ . В этом случае матрица  $M_f(\xi_0)$  полностью соответствует параметрам эллипсов захвата  $A(\xi_0)$ ,  $B(\xi_0)$  и  $\Gamma(\xi_0)$  идеального квадрупольного поля ввиду периодичности фазы ξ<sub>0</sub>. Данной проблемы не существует при работе в первой области стабильности [17], когда ион пролетает краевое поле за время  $k\pi$ , где k = 0, 1, 2, ..., и период  $\pi$  соответствует периоду ВЧ-поля. Это подтверждается тем, что использование нашей вычислительной программы дает идентичные результаты для условий работы в первой области [11]. В рассматриваемом случае наименьший период временной функции в фигурных скобках (1) и (2) соответствует  $\pi P = 10\pi$ , в результате изменение начальной фазы  $\xi_0$  влета ионов в ВЧ-поле также составляет 10 $\pi$ . Интервал изменения фазы  $\xi_0$  больше оптимального типового времени пролета ( $n_f = 3$ ) краевого поля [10].

В случае импульсного ввода ионов в оптимальную фазу с целью увеличения пропускания КФМ необходимо принимать во внимание сдвиг фаз  $\alpha$  между ВЧ-напряжением и модулирующим напряжением [19]. В обычном режиме работы оптимальный интервал фазы ВЧ-напряжения составляет десятые доли ВЧ-периода [13]. При амплитудной модуляции этот интервал увеличивается на порядок и может составлять 2–4 периода ВЧ-поля (рис. 9). Это технически упрощает процесс синхронизации ввода импульсного пучка ионов в анализатор при импульсной ионизации, например пучком лазера [20].

### Заключение

Таким образом, установлено, что

— начальная фаза  $\xi_0$  влета ионов изменяется на интервале  $0-T_0P$  при параметрическом возбуждении колебаний ионов, где  $T_0 = 2\pi/\Omega$  — период ВЧ-напряжения и  $\omega/\Omega = K/P$  — простая несократимая дробь, K и P целые числа, K < P;

— для фазового согласования матрицы преобразования  $M_f(\xi_0)$  краевого поля с параметрами  $A(\xi_0)$ ,  $B(\xi_0)$  и  $\Gamma(\xi_0)$  эллипсов захвата полного квадрупольного поля необходимо матрицу  $M_f(\xi_0)$  доопределить на интервале  $0-\pi P$ ;

— временной интервал оптимального импульсного ввода ионов в анализатор составляет  $(2-4)T_0$ ;

— необходимо синхронизировать сдвиг фаз  $\alpha$  между ВЧ-напряжением и модулирующим сигналом при фазовом вводе ионов в анализатор.

Знание аксептанса необходимо при расчете и создании источника ионов с требуемым эмиттансом с целью увеличения пропускания фильтра масс.

#### Список литературы

- [1] Devant G. Patent FR. 2, 620, 568. 1989.
- [2] Kozo M. US Patent 5, 227, 629. 1993.
- [3] Kozo M.J. // Mass Spectr. Soc. Jpn. 2009. Vol. 57. N 1. P. 23–29.
- [4] Alfred R.L., Londry F.A., March R.E. // Int. J. Mass Spectr. Ion Proc. 1993. Vol. 124. P. 171–185.
- [5] Sudakov M.Yu., Konenkov N.V., Douglas D.J., Glebova T. // J. Am. Soc. Mass Spectr. 2000. Vol. 11. P. 10–18.
- [6] Konenkov N.V., Sudakov M.Yu., Douglas D.J. // J. Am. Soc. Mass Spectr. 2002. Vol. 13. P. 597–613.
- [7] Paul W., Reinhard H.P., Fon Zhan U. // Z. Phys. 1957. Bd 152. S. 143–182.
- [8] March R.E. Quadrupole Ion Trap Mass Spectr. 2<sup>nd</sup> Ed. Willey, 2005.
- [9] Fischer E. // Z. Phys. 1958. Bd 156. S. 1–26.
- [10] Konenkov N.V., Cousins L.M., Baranov V.I., Sudakov M.Y. // Int. J. Mass Spectr. 2001. Vol. 208. P. 17–27.

- [11] Страшнов Ю.В., Махмудов М.Н., Коненков Н.В. // ЖТФ. 2009. Т. 79. Вып. 5. С. 95–100.
- [12] Konenkov N.V., Korolkov A.N., Makhmudov M.N. // J. Am. Soc. Mass Spectr. 2005. Vol. 16. P. 379–387.
- [13] Quadrupole Mass Spectrometry and its Applications / Ed. by P.H. Dawson. NY: American Institute of Physics, 1995.
- [14] Hunter K.L., McIntosh B.J. // Int. J. Mass Spectr. Ion Process. 1989. Vol. 87. P. 157–164.
- [15] McIntosh B.J., Hunter K.L. // Int. J. Mass Spectr. Ion Process. 1989. Vol. 87. P. 165–179.
- [16] Todd F.J., Waldren F.M., Freer D.A., Turner J.F. // Ion Phys. 1980. Vol. 35. P. 107–150.
- [17] Wiedemann H. Particle accelerator. Physics I. 2<sup>nd</sup> Edition. Springer, 2003. P. 152–157.
- [18] Коненков Н.В. // ЖТФ. 1997. Т. 67. Вып. 10. С. 121-124.
- [19] Корольков А.Н., Черняк Е.Я., Страшнов Ю.В., Коненков Н.В. // Масс-спектрометрия. 2009. Т. 6. № 1. С. 53-60.
- [20] *Kuzuya M., Ohoka H., Katoh H.* et al. // Spectrochimica ACTA. Pt B. 1998. Vol. 5 (3). P. 123–129.